

增強的鎖相熱發射



缺陷或性能不佳的半導體器件通常會表現出異常的局部功耗分佈，最終會導致局部溫度增高。

ELITE 利用鎖相紅外熱成像 (LIT) 技術，可準確而高效地確定這些關注區域的位置，可以提供大幅改善的信噪比、提升的靈敏度和更高的特徵解析度。

在 IC 分析中，LIT 可用來確定線路短路、ESD 缺陷、氧化傷害、缺陷電晶體和二極體，以及器件門鎖。

